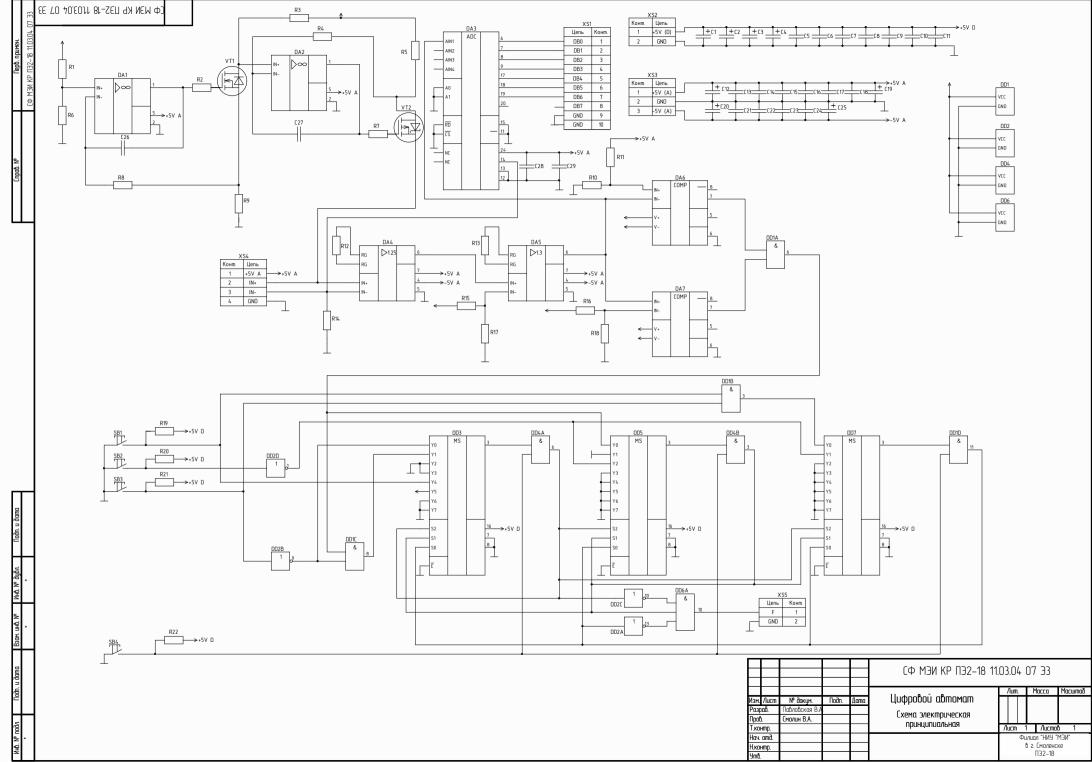
П	Поз. обозна-	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.	<u> 4ehue</u>	Конденсаторы		
	[1[4	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	4	
	<u> </u>		7	
	[12	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	1	
		0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	6	
Ш		TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	2	
	<u>[21[24</u>	0805-X7R-50 B-0,1 mkΦ±10%	4	
	<i>C25</i>	TECAP-A-50 B-1 MKΦ±10%	1	
οN	<i>[26]</i>	0805-X7R-50 B-1000 πΦ±10%	1	
npaß. Nº	<i>C27</i>	0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10%	1	
1)	<i>C28</i>	0805-X7R-50 B-0,1 MKΦ±10%	1	
	<i>C29</i>	1206-X5R-10 B-47 ΜκΦ±20%	1	
		Микросхемы		
	DA 1,DA2	OPAX333 (SOT-23)	2	
	_	AD7824 (SOIC-24)	1	
DU		INA 118E_BB (SOIC-8)	2	
и дап.	DA6,DA7	AD8561 (SOIC-8)	2	
Тодп. и	DD1	MC74ACTO8DG (SOIC-14)	1	
	DD2	CD4044B (SOIC-16)	1	
Ώ	<i>DD3</i>	74HC40510 (TSOP-16)	1	
инв. № дубл.	DD4	MC74ACTO8DG (SOIC-14)	1	
MHB.	<i>DD5</i>	74HC40510 (TSOP-16)	1	
<i>No</i>	<i>DD6</i>	MC74ACTO8DG (SOIC-14)	1	
инв. No	<i>DD7</i>	74HC40510 (TSOP-16)	1	
Взам.				
	┥	Резисторы		
э. и дата	R1	0805-0.125-3 кОм ±1%	1	
	<i>R2</i>	0805-0.125-200 Om ±1%	1	
Подп.	Изм. Лист	СФ МЭИ КР ПЭ2—18 № докум. Подп. Дата	11.0	03.04 07 17.33
оди:		โดกภกครหกุ BA	,	Лит. Лист Листов 1 2
инв. N ^о подл.	Н.КОНПР.	молин В.А. Цифровой автомал Перечень элементов		Филиал НИУ "МЭИ" В г. Смоленске
*	Утв.	Konupoban		ПЭ2–18 Формат А4

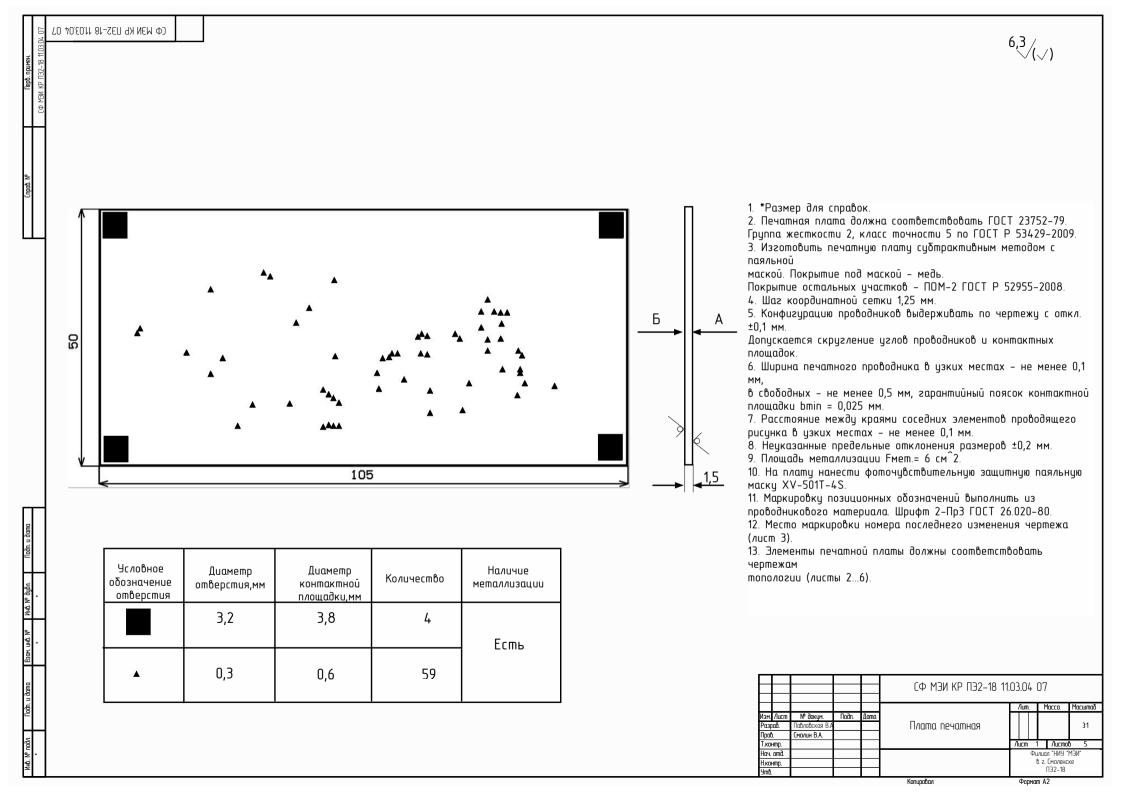
/ 103. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
R3	0805-0.125-470 Om ±1%	1	
R4	0805-0.125-10 kOm ±1%	1	
<i>R5</i>	0805-0.125-4.7 Om ±1%	1	
<i>R6</i>	0805-0.125-2 kOm ±1%	1	
<i>R7</i>	0805-0.125-330 Om ±1%	1	
R8	0805-0.125-10 kOm ±1%	1	
R9	0805-0.125-2 кОм ±1%	1	
R10	0805-0.125-1.5 kOm ±1%	1	
R11	0805-0.125-8.2 kOm ±1%	1	
R12	0805-0.125-200 кОм ±1%	1	
R13	0805-0.125-160 кОм ±1%	1	
R14	0805-0.125-51 kOm ±1%	1	
R15	0805-0.125-7.5 кОм ±1%	1	
R16	0805-0.125-1 кОм ±1%	1	
R17	0805-0.125-2.2 kOm ±1%	1	
R18	0805-0.125-56	1	
R19R22	0805-0.125-10 кОм ±1%	4	
SB1SB4	Устройство коммутационное IT-1187USMD	4	
	Т <i>ранзисторы</i>		
VT1	SI2304DDS-TI-GE3	1	
VT2	NTF2955T1G	1	
	Соединения контактные		
XS1	CI1110M1H	1	
XS2	CI1102M1H	1	
XS3	C11103M1H		
XS4	CI1104M1H	1	
XS5	CI1102M1H	1	
	СФ МЭИ КР ГЛЭ2-18	11.02	$O(\sqrt{O7}/\sqrt{7})^{1/2}$

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Э. примен.					<u>Документация</u>		
Перв	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 .СБ	Сборочный чертеж		
	<u>A2</u>			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 .ЭЗ	Схема электрическая принципиальная		
: No	A4			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 .ПЭЗ	,		
Справ					<u>Детали</u>		
	A2		1	СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07	Плата печатная	1	
					Прочие изделия		
Подп. и дата			2		Конденсаторы 0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	18	C5C12 C13C18 C21C24
т. инв. № Дибл.			3 4 5 6		0805-X7R-50 B-1000 πΦ±10% 0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10% 1206-X5R-10 B-47 ΜκΦ±20% TECAP-A-50 B-1 ΜκΦ±10%	1	C28 C26 C27 C29 C1C4,C12 C19,C20
: и дата Взам.							C25
№ подл. Подп.	_	1. /lul 3pað. ah		№ докум. Подп. Дата авловская В.А	13V1 KP 1732-18 11.03	8.04 /lucm 1	. 07 <u>Aucmob</u> 3
MHB. Nº n		ОНПІ		Копирова		, РМО/П	A4

	10 11 12 13 14 15 16 17		Микросхемы 74HC40510 (TS0P-16) AD7824 (S0IC-24) AD8561 (S0IC-8) CD4044B (S0IC-16) INA118E_BB (S0IC-8) MC74ACT08DG (S0IC-14) Pesucmopы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1% 0805-0.125-330 Ом ±1%	1 2 1 2	DD3,DD5 DD7 DA3 DA6,DA7 DD2 DA4,DA5 DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2 R7			
	10 11 12 13 14 15 16 17		74HC4O51O (TSOP-16) AD7824 (SOIC-24) AD8561 (SOIC-8) CD4O44B (SOIC-16) INA118E_BB (SOIC-8) MC74ACTO8DG (SOIC-14) Pesucmopы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	1 2 1 2 3 2 1 1 1	DD7 DA3 DA6,DA7 DD2 DA4,DA5 DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	10 11 12 13 14 15 16 17		AD7824 (SOIC-24) AD8561 (SOIC-8) CD4044B (SOIC-16) INA118E_BB (SOIC-8) MC74ACT08DG (SOIC-14) Pesucmopы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	1 2 1 2 3 2 1 1 1	DD7 DA3 DA6,DA7 DD2 DA4,DA5 DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	9 10 11 12 13 14 15 16 17		AD8561 (SOIC-8) CD4044B (SOIC-16) INA118E_BB (SOIC-8) MC74ACT08DG (SOIC-14) ОРАХЗЗЗ (SOT-23) Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	2 1 2 3 2 1 1 1	DA3 DA6,DA7 DD2 DA4,DA5 DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	9 10 11 12 13 14 15 16 17		AD8561 (SOIC-8) CD4044B (SOIC-16) INA118E_BB (SOIC-8) MC74ACT08DG (SOIC-14) ОРАХЗЗЗ (SOT-23) Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	2 1 2 3 2 1 1 1	DA6,DA7 DD2 DA4,DA5 DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	10 11 12 13 14 15 16 17		СD4044B (SOIC-16) INA118E_BB (SOIC-8) MC74ACT08DG (SOIC-14) ОРАХЗЗЗ (SОТ-23) Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	1 2 3 2 1 1 1	DD2 DA4,DA5 DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	11 12 13 14 15 16 17		INA 118E_BB (SOIC-8) MC74ACTO8DG (SOIC-14) OPAX333 (SOT-23) Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-56 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	2 3 2 1 1	DA4,DA5 DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	12 13 14 15 16 17		МС74ACT08DG (SOIC-14) OPAX333 (SOT-23) Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-56 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	3 2 1 1 1	DD1,DD4 DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	13 14 15 16 17		OPAX333 (SOT-23) Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-56 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	2 1 1	DD6 DA1,DA2 R5 R18 R2			
	14 15 16 17		Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-56 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	1 1 1	DA1,DA2 R5 R18 R2			
	14 15 16 17		Резисторы 0805-0.125-4.7 Ом ±1% 0805-0.125-56 Ом ±1% 0805-0.125-200 Ом ±1%	1 1 1	R5 R18 R2			
	15 16 17		0805-0.125-4.7 Om ±1% 0805-0.125-56 Om ±1% 0805-0.125-200 Om ±1%	1	R18 R2			
	15 16 17		0805-0.125-4.7 Om ±1% 0805-0.125-56 Om ±1% 0805-0.125-200 Om ±1%	1	R18 R2			
	15 16 17		0805-0.125-56 Om ±1% 0805-0.125-200 Om ±1%	1	R18 R2			
	16 17		0805-0.125-200 Om ±1%	1	R2			
	17							
			1/18/15-//1/5-11/1/M +1% 1	. /	10/			
	1 4(1)			L	1			
	18		0805-0.125-470 0M ±1%	1	R3			
	19		0805-0.125-1 KOM ±1%	1	R16			
	20		0805-0.125-1.5 kOm ±1%	1	R10			
	21		0805-0.125-2 KOM ±1%	1	R6,R9			
	22		0805-0.125-2.2 KOM ±1%	1	R17			
	23		0805-0.125-3 kOm ±1%	1	R1			
+	24		0805-0.125-7.5 kOm ±1%	1	R15			
-	25		0805-0.125-8.2 KOM ±1%	1	R11			
-	26		0805-0.125-10 k0m ±1%	6	R4,R8			
-	07		0005 0405 54 0 407	1	R19R22			
4	27		0805-0.125-51 k0m ±1%	1	R14			
4	28		0805-0.125-160 k0m ±1%	1	<i>R13</i>			
+	29		0805-0.125-200 k0m ±1%	1	<i>R12</i>			
+				-				
\perp			 МЭИ КО ПЭЭ 10 11∩ЭЛ	 7/	07 /ucm			
Изм. /	-	Изм. Лист № докум. Подп. Дата СФ МЭИ КР ПЭ2—18 11.03.04 07 2						

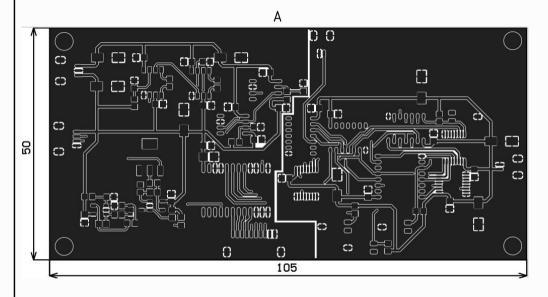
Фармат	JUHU []n3	<i>Обозначение</i>	Наименование	Кол.	Приме- чание
			C7		
	+	0	Соединения контактные	2	VCOVC
_	30		C11102M1H	2	XS2,XS
_	3		C11103M1H	1	XS3
_	32		C11104M1H	1	XS4
-	3.	3	C11110M1H	1	XS1
			Транзисторы		
	34	4	NTF2955T1G	1	VT2
	3		SI2304DDS-TI-GE3	1	VT1
_	7.		//cmpo/cmbo woww.mg/wow.	/	CD1 CD
+	30	7	Устройство коммутационное	4	SB1SB
+		+	1T-1187USMD		
\perp					
+	+				
+					
+	+				
+					
	7	$\mathcal{L}\phi$	Р МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.0	74 (07
Изм. /	Nucm	№ докум. Подп. Цата	Копировал Форг		A4 -

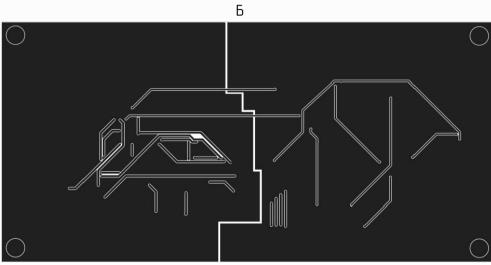




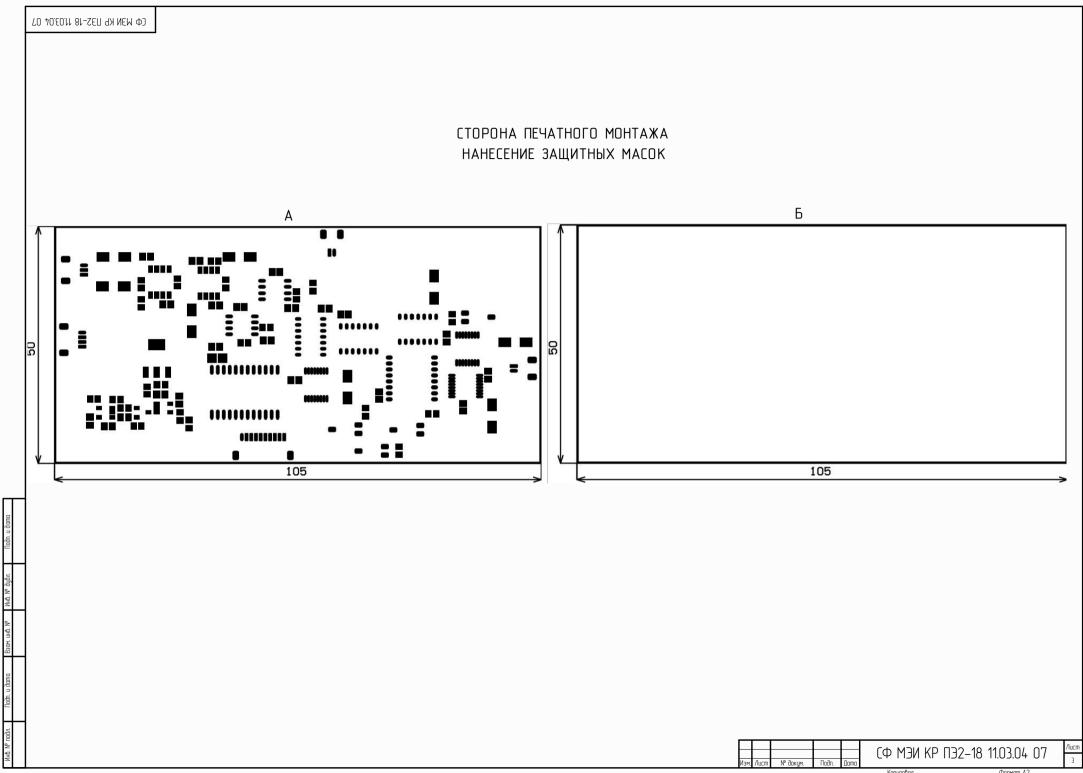
CΦ W3N Kb U35-18 11'03'0¢ 07

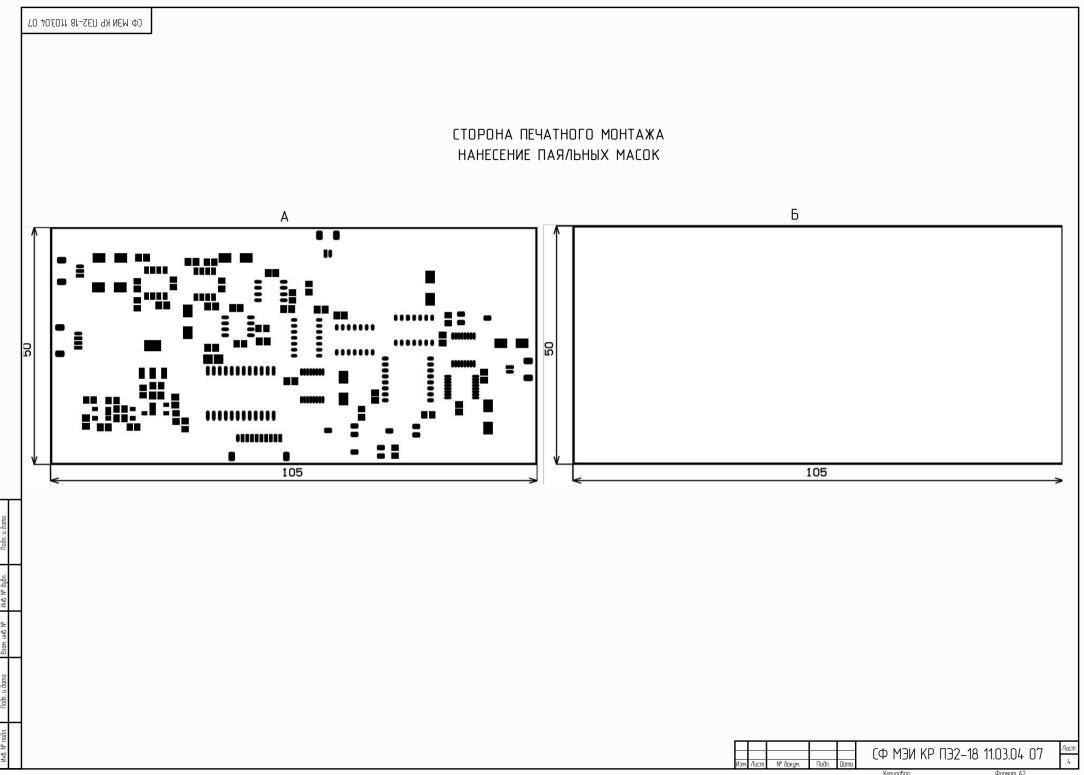
СТОРОНА ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА





СФ МЭИ КР ПЭ2–18 11.03.04 07





CΦ W3N Kb U35-18 11'03'0¢ 07

ВЕРХНИЙ СЛОЙ МАРКИРОВКИ

Α

